

1.9 GHz PHS 用シリコン高周波増幅器 IC

μPC8217TU は 1.9 GHz PHS などのロウ・ノイズ・アンプ + ミキサとして開発したシリコン・モノリシック IC です。

パッケージは高密度表面実装に適した 8 ピン・リードレス・ミニモールド・パッケージを採用しています。

本製品は、当社独自の Si バイポーラ・プロセス「UHS0」 (Ultra High Speed Process) により生産しています。

特 徴

- 低雑音 : NF = 4.2 dBm TYP.
- 高利得 : CG = 22.5 dB TYP.
- 低消費電流 : Icc = 11.5 mA TYP.
- 高密度・面実装に最適 : 8 ピン・リードレス・ミニモールド (2.0 × 2.2 × 0.5 mm)

用 途

PHS 1.9 GHz など

オーダ情報

オーダ名称	パッケージ	捺 印	包装形態
μPC8217TU-E2	8 ピン・リードレス・ミニモールド	8217	<ul style="list-style-type: none"> ・ 8 mm 幅エンボス式テーピング ・ 5, 6, 7, 8 ピンはテープ引き出し方向 ・ 5 k 個 / リール

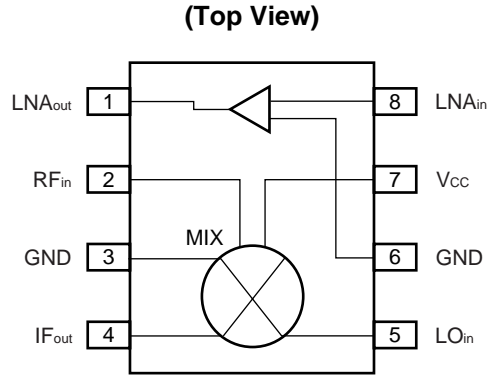
備考 評価用サンプルのオーダについては、販売員にお問い合わせください。

サンプル名称 : μPC8217TU

本製品は高周波プロセスを用いていますので、静電気などの過大入力にご注意ください。

本資料の内容は、予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。

端子接続図および内部ブロック図



絶対最大定格（特に指定のないかぎり $T_A = +25^{\circ}\text{C}$ ）

項目	略号	条件	定格	単位
電源電圧 (LNA)	$V_{CC(LNAout)}$		3.6	V
電源電圧 (MIX)	$V_{CC(IFout)}$		3.6	V
回路電流	I_{CC}		23	mA
最大入力電力 (LNA)	P_{LNAin}		+ 10	dBm
最大入力電力 (MIX)	P_{LOin}		+ 10	dBm
動作周囲温度	T_A		- 30 ~ + 70	$^{\circ}\text{C}$
保存温度	T_{stg}		- 55 ~ + 150	$^{\circ}\text{C}$
パッケージ許容損失	P_D	注	1.06	W

注 33×21×0.4 mm ガラス・エポキシ基板実装時

推奨動作範囲

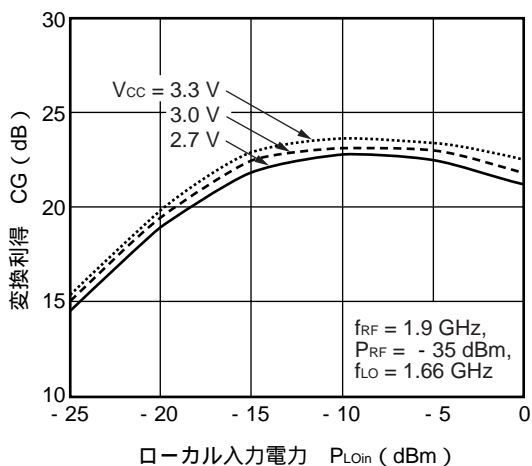
項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電圧 (LNA)	$V_{CC(LNAout)}$		2.7	3.0	3.3	V
電源電圧 (MIX)	$V_{CC(IFout)}$		2.7	3.0	3.3	V
動作周囲温度	T_A		- 30	+ 25	+ 70	$^{\circ}\text{C}$
RF 入力周波数 (MIX)	f_{RFin}		1.8	1.9	2.0	GHz
ローカル入力電力	P_{LOin}		- 15	- 10	- 5	dBm

電気的特性 (特に指定のないかぎり $V_{CC} = 3.0\text{ V}$, $T_A = +25^\circ\text{C}$, $Z_S = Z_L = 50\ \Omega$, $f_{RF} = 1.9\text{ GHz}$, $f_{IF} = 240\text{ MHz}$, $f_{LO} = 1.66\text{ GHz}$, $P_{LO} = -10\text{ dBm}$)

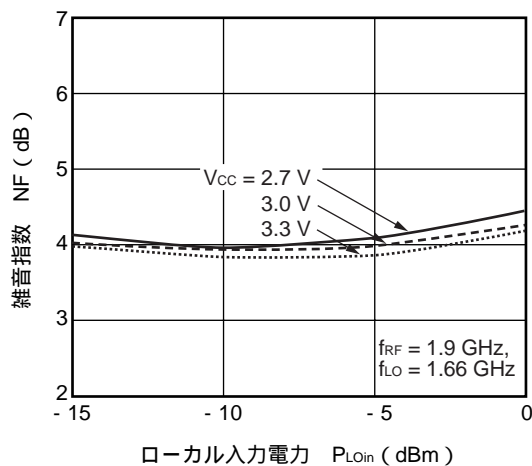
項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
回路電流	I _{CC}	無信号時	8.5	11.5	15.0	mA
変換利得	CG	$P_{RFin} = -35\text{ dBm}$	17.2	22.5	27.5	dB
雑音指数	NF	SSB	-	4.2	5.3	dB
入力3次ひずみ インタセプト・ポイント	IIP ₃	$f_{RF1} = 1.9\text{ GHz}$, $f_{RF2} = 1.9006\text{ GHz}$, $P_{RF} = -35\text{ dBm/ tone}$	-17	-15	-	dBm
イメージ抑圧比	IMR	$f_{RF1} = 1.9\text{ GHz}$, $f_{RF2} = 1.42\text{ GHz}$, $P_{RF} = -35\text{ dBm/ tone}$	30	36	-	dBc
1/2 IF 抑圧比	1/2 IFR	$f_{RF1} = 1.9\text{ GHz}$, $f_{RF2} = 1.78\text{ GHz}$, $P_{RF} = -35\text{ dBm/ tone}$, 240 MHz 出力	40	50	-	dBc
Lo リーク	LoLeak	RF ポート	-	-49	-	dBm

特性曲線 (特に指定のないかぎり $T_A = +25^\circ\text{C}$, 参考値)

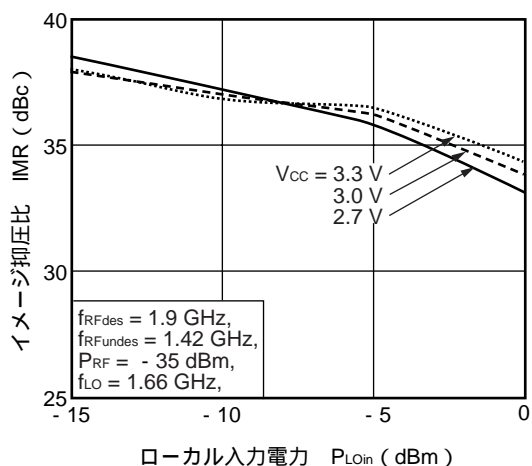
変換利得 vs. ローカル入力電力



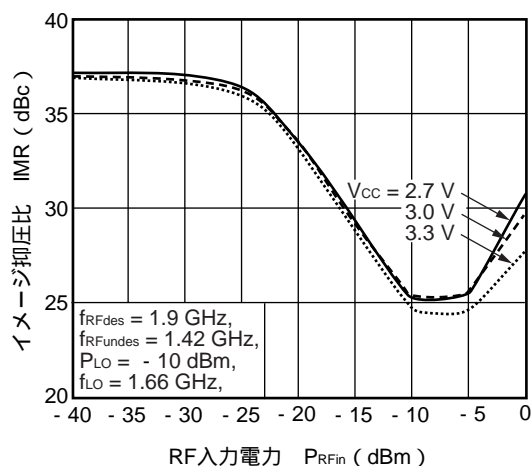
雑音指数 vs. ローカル入力電力



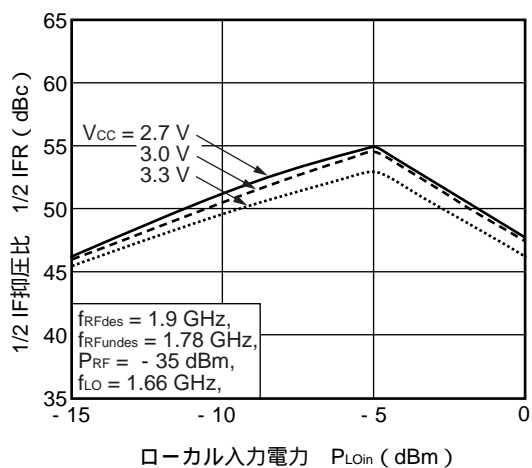
イメージ抑圧比 vs. ローカル入力電力



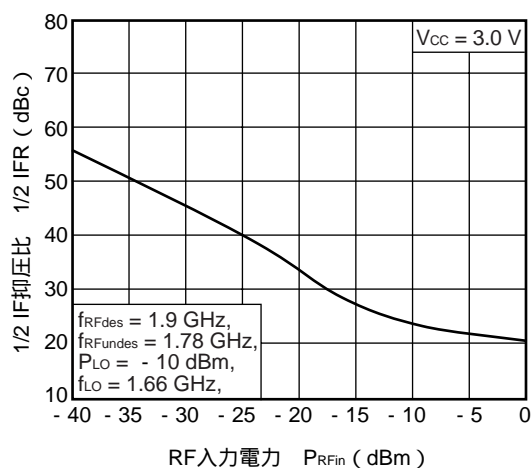
イメージ抑圧比 vs. RF入力電力



1/2 IF抑圧比 vs. ローカル入力電力

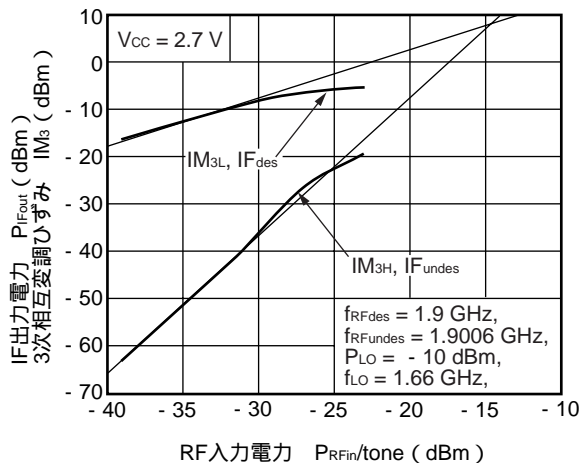


1/2 IF抑圧比 vs. RF入力電力

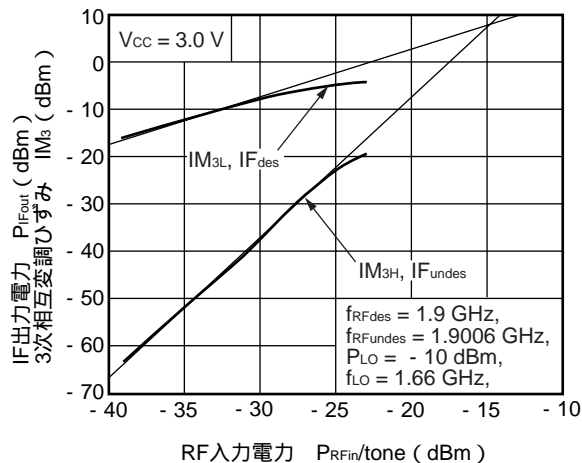


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

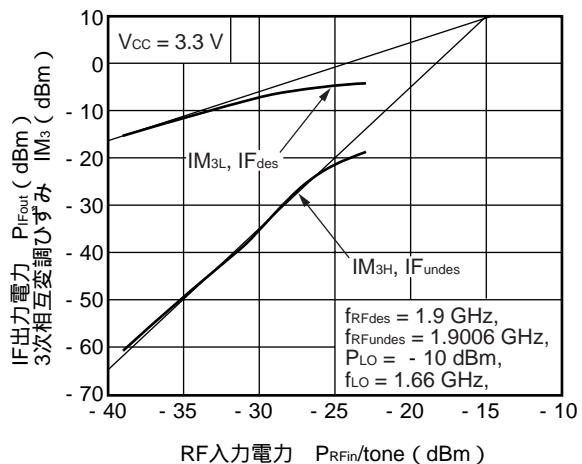
IF出力電力, IM₃ vs. RF入力電力



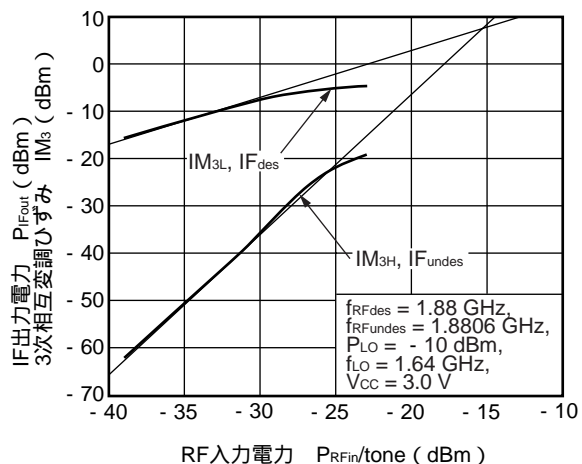
IF出力電力, IM₃ vs. RF入力電力



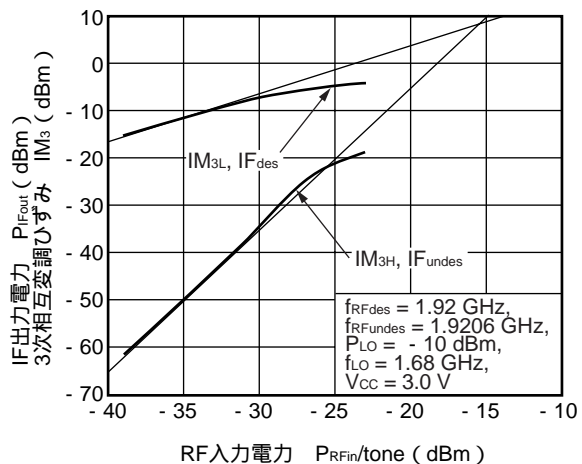
IF出力電力, IM₃ vs. RF入力電力



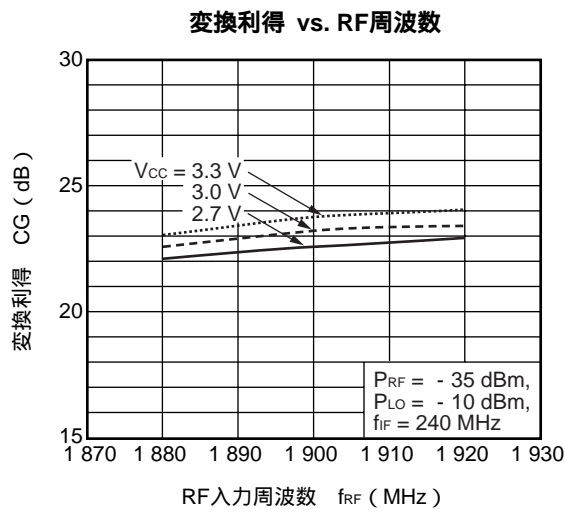
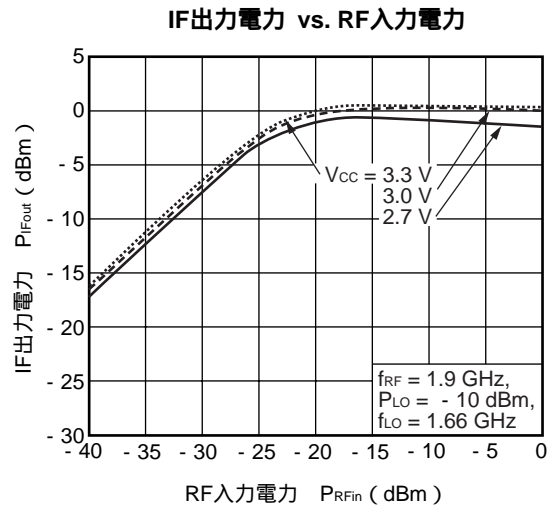
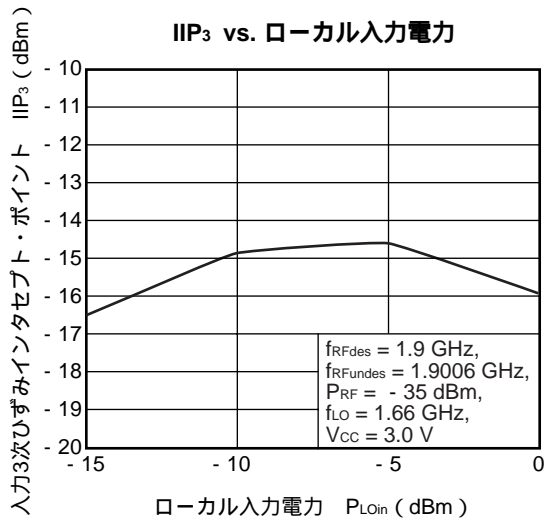
IF出力電力, IM₃ vs. RF入力電力



IF出力電力, IM₃ vs. RF入力電力



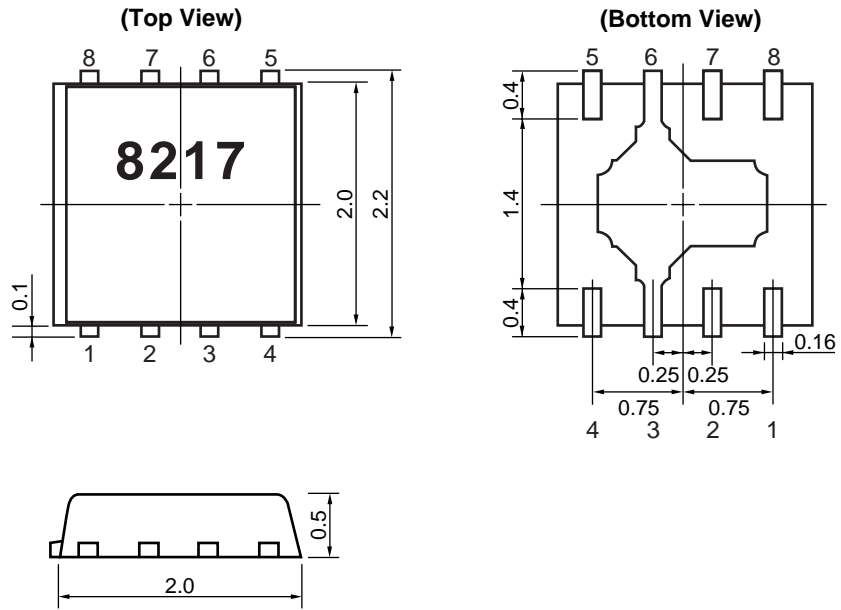
備考 グラフ中の値は参考値を示します。



備考 グラフ中の値は参考値を示します。

外形図

8ピン・リードレス・ミニモールド (単位: mm)



使用上の注意事項

- (1) 本製品は高周波プロセスを用いていますので、静電気などの過大入力にご注意ください。
- (2) グランド・パターンは極力広く取り、接地インピーダンスを小さくしてください(異常発振の防止のため)。
特にグランド端子はインピーダンス差が生じないようにパターンをつなげてください。
- (3) Vcc 端子にはバイパス・コンデンサを挿入してください。

半田付け推奨条件

この製品の半田付け実装は、次の推奨条件で実施してください。

なお、推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については、当社販売員にご相談ください。

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
赤外線リフロ	<ul style="list-style-type: none"> ・ 最高温度 (パッケージ表面温度) : 260°C 以下 ・ 最高温度の時間 : 10 秒以内 ・ 温度 220°C 以上の時間 : 60 秒以内 ・ プリヒート温度 120 ~ 180°C の時間 : 120±30 秒 ・ 最多リフロ回数 : 3 回 ・ ロジン系フラックスの塩素含有量 (質量百分率) : 0.2% (Wt.) 以下 	IR260
VPS	<ul style="list-style-type: none"> ・ 最高温度 (パッケージ表面温度) : 215°C 以下 ・ 温度 200°C 以上の時間 : 25 ~ 40 秒 ・ プリヒート温度 120 ~ 150°C の時間 : 30 ~ 60 秒 ・ 最多リフロ回数 : 3 回 ・ ロジン系フラックスの塩素含有量 (質量百分率) : 0.2% (Wt.) 以下 	VP215
ウェーブ・ソルダーリング	<ul style="list-style-type: none"> ・ 最高温度 (溶融半田温度) : 260°C 以下 ・ フロー時間 : 10 秒以内 ・ プリヒート温度 (パッケージ表面温度) : 120°C 以下 ・ フロー回数 : 1 回 ・ ロジン系フラックスの塩素含有量 (質量百分率) : 0.2% (Wt.) 以下 	WS260
端子部分加熱	<ul style="list-style-type: none"> ・ 最高温度 (端子部温度) : 350°C 以下 ・ 時間 (デバイスの一辺あたり) : 3 秒以内 ・ ロジン系フラックスの塩素含有量 (質量百分率) : 0.2% (Wt.) 以下 	HS350

注意 半田付け方式の併用はお避けください (ただし、端子部分加熱は除く)。

- 本資料の内容は予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。
 - 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
 - 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。
 - 本資料に記載された回路、ソフトウェア、及びこれらに付随する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するためのものです。従って、これら回路・ソフトウェア・情報をお客様の機器に使用される場合には、お客様の責任において機器設計をしてください。これらの使用に起因するお客様もしくは第三者の損害に対して、当社は一切その責を負いません。
 - 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
 - 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。
 - 標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
 - 特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災/防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器
 - 特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等
- 当社製品のデータ・シート/データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

M7 98.8

NEC化合物デバイス株式会社 http://www.ncsd.necel.com/index_j.html

営業に関する問い合わせ先

営業本部 事業推進グループ TEL: 044-435-1573
E-mail: salesinfo@ml.ncsd.necel.com
FAX: 044-435-1579

技術に関する問い合わせ先

営業本部 販売技術グループ TEL: 044-435-1577
E-mail: techinfo@ml.ncsd.necel.com
FAX: 044-435-1918